

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のメモリセルと、前記メモリセルが接続されたビット線対と、第1の制御信号に応じて前記ビット線対を第1の電圧にプリチャージするための複数のプリチャージ回路と、前記プリチャージ回路にプリチャージ用の電圧を供給するビット線プリチャージ電圧発生装置とを備え、ビット線のイコライズ電圧と前記第1の電圧が異なる半導体記憶装置であって、前記ビット線プリチャージ電圧発生装置は、前記第1の電圧を発生して前記プリチャージ回路に供給するプリチャージ電圧発生回路と、第1のキャパシタと、前記第1のキャパシタを充電する充電手段と、前記第1のキャパシタと前記プリチャージ回路との接続・切斷を制御するトランスファークラーク回路と、前記充電手段と前記トランスファークラーク回路を制御する第1の制御回路とを具備し、

前記第1の制御回路は、前記ビット線のプリチャージ時に前記第1のキャパシタと前記プリチャージ回路とを接続するように前記トランスファークラーク回路を制御することを特徴とする半導体記憶装置。

【請求項2】 前記プリチャージ電圧発生回路は、第2の電圧を発生する基準電圧発生装置と、前記第1の電圧を前記第2の電圧と等しい電圧に駆動するドライバ回路とを備え、前記ドライバ回路の出力と、前記プリチャージ回路とが接続されていることを特徴とする請求項1に記載の半導体記憶装置。

【請求項3】 前記第1のキャパシタはソース・ドレインが接地された第1のMOSトランジスタで構成され、前記充電手段はゲートが第2の制御信号に、ソースが第1の外部電源に、ドレインが前記第1のMOSトランジスタのゲートに接続された第1のPチャネルMOSトランジスタで構成され、前記トランスファークラーク回路は、ゲートに第2の制御信号が入力され、ソースを前記第1のMOSトランジスタのゲートに、ドレインをプリチャージ回路に接続された第1のNチャネルMOSトランジスタと、入力に前記第2の制御信号が供給される第1のインバータと、ゲートに前記第1のインバータの出力が入力され、ソースを前記第1のMOSトランジスタのゲートに、ドレインを前記プリチャージ回路に接続された第2のPチャネルMOSトランジスタで構成されたことを特徴とする請求項1に記載の半導体記憶装置。

【請求項4】 前記第1の制御回路は、前記第1の制御信号が、前記プリチャージ回路を活性化させる電圧にされてから第1の遅延時間の後に前記第2の制御信号を第1の電圧レベルに制御し、さらに第2の遅延時間の後に、前記第2の制御信号を第1の電圧レベルと逆相の電圧に制御することを特徴とする請求項1に記載の半導体記憶装置。

【請求項5】 第1の外部電源電圧と前記第2の電圧との差を第1の電圧差とし、前記ビット線対の各電圧の平

均の電圧と前記第2の電圧との差を第2の電圧差とし、同時にプリチャージする前記ビット線対の総静電容量を第1の静電容量とすると、前記第1のキャパシタの静電容量は、前記第1の電圧差に対する前記第2の電圧差の比に前記第1の静電容量を乗じた第2の静電容量に等しいことを特徴とする請求項2に記載の半導体記憶装置。

【請求項6】 第1の外部電源電圧と前記第2の電圧との差を第1の電圧差とし、前記ビット線対の各電圧の平均の電圧と前記第2の電圧との差を第2の電圧差とし、同時にプリチャージする前記ビット線対の総静電容量を第1の静電容量とすると、前記第1のキャパシタの静電容量は、前記第1の電圧差に対する前記第2の電圧差の比に前記第1の静電容量を乗じた第2の静電容量の約50%から80%の値であることを特徴とする請求項2に記載の半導体記憶装置。

【請求項7】 前記複数のメモリセルのデータを、リフレッシュ制御信号に応じてリフレッシュするための機能を有し、リフレッシュ動作時には、通常動作より多くの前記ビット線対を活性化するように構成され、前記第1の制御回路は前記リフレッシュ制御信号がリフレッシュ動作時を示すレベルの時のみに、前記第1の制御信号に応じて前記トランスファークラーク回路を開放することを特徴とする請求項1に記載の半導体記憶装置。

【請求項8】 テスト信号が入力されることによりテストモードに入る機能を有し、前記テストモードでない場合には、前記第1の制御信号に応じて前記トランスファークラーク回路を開放し、前記テストモードの場合には、前記ドライバ回路が停止し、前記ドライバ回路の出力がハイインピーダンスとなり、前記トランスファークラーク回路を閉じていることを特徴とする請求項1に記載の半導体記憶装置。

【請求項9】 前記プリチャージ電圧発生回路は、前記複数のプリチャージ回路のうち、最遠部近傍に配置された前記プリチャージ回路に供給される前記第1の電圧を前記第2の電圧と比較し、その比較結果に基づいて、最近部近傍に配置された前記プリチャージ回路に供給される前記第1の電圧を駆動することを特徴とする請求項2に記載の半導体記憶装置。

【請求項10】 前記複数のメモリセルは複数のメモリアレイブロックに区分され、各々の前記メモリアレイブロックは、前記第1の制御信号によって同時に駆動される前記複数のプリチャージ回路に接続された前記複数のメモリセルを含み、前記メモリアレイブロックごとにノイズキャンセラが配置され、前記ノイズキャンセラは、第2のインバータと、第2のキャパシタで構成され、前記第1の制御信号が前記第2のインバータに入力され、前記第2のインバータの出力が、前記第2のキャパシタの1端子に入力され、前記第2のキャパシタの別端子に、前記プリチャージ用の電圧が供給されることを

3

特徴とする請求項1に記載の半導体記憶装置。

【請求項11】 複数のメモリセルと、前記メモリセルが接続されたビット線対と、第1の制御信号に応じて前記ビット線対を第1の電圧にプリチャージするための複数のプリチャージ回路と、前記プリチャージ回路にプリチャージ用の電圧を供給するビット線プリチャージ電圧発生装置とを備え、ビット線のイコライズ電圧と前記第1の電圧が異なり、さらに第3の制御信号に応じて同時に活性化させる前記ビット線対の数を変更する機能を有する半導体記憶装置であって、

前記ビット線プリチャージ電圧発生装置は、前記第1の電圧を発生して前記プリチャージ回路に供給するプリチャージ電圧発生回路と、複数のキャパシタ制御回路と、前記複数のキャパシタ制御回路を制御する第2の制御回路とを具備し、

各々の前記キャパシタ制御回路は、第3のキャパシタと、前記第3のキャパシタを充電する充電手段と、前記第3のキャパシタと前記プリチャージ回路との接続・切断を制御するトランスファークラップ回路から構成され、前記第2の制御回路は、前記第3の制御信号に応じて、制御する前記複数のキャパシタ制御回路の数を変更する機能を具備することを特徴とする半導体記憶装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体記憶装置、特に、DRAM（ダイナミック・ランダム・アクセスメモリ）において、ビット線の中間電位と異なる場合に、プリチャージ動作を高速に行なうことが可能なビット線プリチャージ電圧発生装置を備えた半導体記憶装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来のビット線プリチャージ電圧発生装置が搭載される、半導体記憶装置の回路構成および動作について図面を参照しながら説明する。

【0003】図19は、一般的なDRAM5000の機能ブロック図を示す。4000はメモリアレイ、4001はメモリアレイブロック、4002は電源ブロック、4003はロウコントローラ、4004はカラムコントローラ、4005は制御回路、4006はI/Oバッファである。

【0004】メモリアレイ4000は、複数のメモリアレイブロック4001を含む。各メモリアレイブロック4001には、電源ブロック4002よりビット線プリチャージ電圧VBPおよび、メモリセルプレート電圧VCP等のメモリアレイ4000に必要な電圧が供給される。各メモリアレイブロック4001は、ロウコントローラ4003より入力される、ビット線プリチャージ信号NEQ、センスアンプ起動信号SAN、SAP、およびワード線駆動信号WL[63:0]により制御される。また、各メモリアレイブロック4001には、カラム

4

ムコントローラ4004が接続される。

【0005】ロウコントローラ4004には制御回路4005より、アクセスコントロール信号SE、ロウアドレス信号RADが入力される。カラムコントローラ4004には制御回路4005より、ライトイネーブル信号WEN、カラムアドレス信号CADが入力される。

【0006】制御回路4005には外部クロック信号CLK、ロウアドレスストロブ信号NRAS、カラムアドレスストロブ信号NCAS、ライト制御信号NWE、アドレスADDR、リフレッシュ制御信号REFが入力される。

【0007】カラムコントローラ4004は、I/Oバッファ4006に接続される。I/Oバッファ4006には、データ入力信号DIが入力され、データ出力信号DOを出力する。

【0008】図20は、メモリアレイブロック4001の回路図を示す。4100はメモリセル、4101はセンスアンプ、4102はプリチャージ回路、BL[n]（n=0、1、・・・）はビット線、/BL[n]（n=0、1、・・・）は、BL[n]と対となるビット線である。メモリセル4100は、Pチャネルトランジスタである1つのアクセストランジスタ4103とキャパシタ4104で構成される。アクセストランジスタ4103は、ソースがビット線BL[n]または、/BL[n]に、ドレインがキャパシタ4104に、ゲートがワード線駆動信号WL[n]に接続される。キャパシタ4104の他方のノードは、メモリセルプレート電圧VCPに接続される。

【0009】センスアンプ4101は一般的なクロスカプル方式のセンスアンプであり、対となるビット線BL[n]、/BL[n]に接続される。センスアンプ4101は、センスアンプ起動信号SAN、SAPで制御される。プリチャージ回路4102は、3つのPチャネルトランジスタ、すなわち、ソースがビット線BL[n]に、ドレインがビット線/BL[n]に、ゲートがビット線プリチャージ信号NEQ線に接続されるトランジスタと、ソースがビット線プリチャージ電圧VBPに、ゲートがビット線プリチャージ信号NEQ線に接続されるトランジスタと、ドレインがビット線/BL[n]に、ゲートがビット線プリチャージ信号NEQ線に接続されるトランジスタで構成される。

【0010】図21は、ビット線プリチャージ電圧VBPの電源配線ネットの図を示す。メモリアレイ4000上には、複数配置されるメモリアレイブロック4001内に配置される、プリチャージ回路4102にビット線プリチャージ電圧VBPを供給するためのビット線プリチャージ電源配線VBP[n]が配置される。ビット線プリチャージ電源配線VBP[n]は、プリチャージ

ジ電圧発生回路4200に近い側から、VBP [0]、VBP [1]、・・・VBP [n]とする。ビット線プリチャージ電源配線VBP [n]は、各メモリアレイブロック4001の上層の配線層でカラム方向に配置される(図上では実線で示される)。各ビット線プリチャージ電源配線VBP [n]はインピーダンスを下げるために、それぞれロウ方向に金属配線で接続される(図上では破線で示される)。このようにメッシュ状に配置され、またできるだけ太い配線が使用される。ビット線プリチャージ電源配線VBP [0]は、プリチャージ電圧発生回路4200に接続される。

【0011】図22は、従来のプリチャージ電圧発生回路4200の回路構成を示す。4300は基準電圧発生回路、4301はオペアンプ、4302はPチャネルトランジスタである。VBPREFはビット線プリチャージ基準電圧、VOUITはビット線プリチャージ保持電圧、PENはドライバインピーナブル信号である。基準電圧発生回路4300は、ビット線プリチャージ基準電圧VBPREFおよびビット線プリチャージ保持電圧VOUITを発生する構成である。ビット線プリチャージ基準電圧VBPREFはオペアンプ4301の－入力に、ビット線プリチャージ保持電圧VOUITは、ビット線プリチャージ電源配線VBP [0]に接続される。オペアンプ4301の＋入力にはビット線プリチャージ電源配線VBP [0]が接続され、出力はドライバインピーナブル信号PENであり、Pチャネルトランジスタ4302のゲートに入力される。Pチャネルトランジスタ4302のソースはVDDに、ドレインはビット線プリチャージ電源配線VBP [0]に接続される。

【0012】図23は、基準電圧発生回路4300の回路図を示す。4400は抵抗(抵抗値R1)、4401は抵抗(抵抗値R2)である。回路構成は一般的な1/2VDD発生回路であり、例えば超LSIメモリ(伊藤清男著、培風館)に詳しく説明されているので詳細な説明は省略する。出力段は、ビット線プリチャージ基準電圧VBPREF発生用、およびビット線プリチャージ保持電圧VOUIT用に2つ用意される。出力される電圧は、 $VOUIT = VBPREF = R2 / (R1 + R2) \times VDD$ となる。R1およびR2の値としては、この回路を構成するトランジスタのオン抵抗より十分に大きい抵抗値が用いられる。

【0013】オペアンプ4301は、図24に示すような一般的なカレントミラー負荷型差動オペアンプ回路である。AMPENは差動アンプ制御信号である。差動入力として－入力にビット線プリチャージ基準電圧VBPREFが、＋入力にビット線プリチャージ電源配線VBP [0]が接続される。出力はドライバインピーナブル信号PENである。差動アンプ制御信号AMPRENがVDDレベルの場合にはオペアンプ4301は動作状態、VSSレベルの場合にはオペアンプ4301は停止

状態となり、消費電流を減らすことができる。本回路は一般的に知られている回路であり、その他詳しい動作原理は省略する。

【0014】図25は、このDRAMの動作タイミングおよび内部電圧タイミングを示す。ここではリード動作のためのワード線WL [n]はハイレベルであり、全てのアクセストランジスタ4103はオフ状態であり、キャパシタ4104には任意の電圧が保持されている。またビット線プリチャージ信号NEQはローレベルで、全てのプリチャージ回路4102は動作状態であり、全てのビット線BL [n]、/BL [n]はビット線プリチャージ電圧VBPにチャージされている。

【0015】外部クロック信号CLKの立ち上がりエッジで、ロウアドレスストローブ信号NRASをローレベルにし、アドレスADDRとし、ワード線選択動作が開始される。ワード線選択動作が開始されると、入力されたロウアドレスで決まる任意のメモリアレイブロック4001に入力されるビット線プリチャージ信号NEQがハイレベルにされる。ビット線プリチャージ信号NEQがハイレベルにされると、当該プリチャージ回路4102は停止する。また、差動アンプ制御信号AMPRENがハイレベルにされ、オペアンプが活性化され、プリチャージ動作に備えられる。

【0016】その後、入力されたロウアドレスで決まる任意のワード線WL [n] 1本がローレベル(VSS)にされ、接続された複数のメモリセル4100がオン状態となり、キャパシタ4104に保持されている電圧が、接続されたビット線BL [n]もしくは/BL [n]に読み出される。その後、センスアンプ起動信号SANがローレベル(VSS)にSAPがハイレベル(VDD)にされ、センスアンプ4101は活性化状態となる。センスアンプ4101が活性化状態となると、ビット線BL [n]もしくは/BL [n]に読み出された任意の電位に基づいて、ビット線BL [n]、/BL [n]がハイレベル(VDD)もしくはローレベル(VSS)にチャージされる。

【0017】ここで、読み出されたメモリセル4100が接続されたワード線WL [n]はローレベル(VSS)とされているので、接続されたビット線BL [n]、/BL [n]の電位がキャパシタ4104に再書き込まれる。アクセストランジスタ4103はPチャネルトランジスタであるため、ローレベルとしてはVtp (VtpはPチャネルトランジスタのしきい値電圧)の電位が、ハイレベルとしてはVDDが書き込まれる。すなわち、キャパシタ4104に書き込まれる電位として、ハイレベルの場合はVDDが、ローレベルの場合はVtpが書き込まれる。ハイレベル読み出し、ローレベル読み出しの電位を共に最適なマージンで読み出す

7

ためには、ビット線プリチャージ電圧VBPは、その中間の値である $1/2(VDD+V_{tp})$ が最適となる。
【0018】その後、外部クロック信号CLKの立ち上がりエッジに同期してカムアドレスストロブ信号NCASをローレベルにし、アドレスADDRとしてカムアドレスを入力することで、カムコントローラ4004が活性化され、データがデータ出力信号DOとして出力される。

【0019】その後、外部クロック信号CLKの立ち上がりエッジに同期して、ロウアドレスストロブ信号NRAS、カムアドレスストロブ信号NCASをハイレベルにすることで、プリチャージ動作が開始される。プリチャージ動作が開始されると、ローレベルとなっていたワード線WL[n]がハイレベルにされ、アクセストランジスタ4103がオフし、キャパシタ4104に電荷が保持される。その後の読み出し動作に備えるために、ビット線プリチャージ信号NEQがローレベルにされ、プリチャージ回路4102が活性化される。

【0020】プリチャージ回路4102が活性化されると、センスアンプ4101により電位をVDD、VSSにされたビット線BL[n]、/BL[n]の電位がイコライズされ、 $1/2VDD$ の電位にチャージされようとする。プリチャージ回路4102は同時に、ビット線BL[n]、/BL[n]を対応するビット線プリチャージ電源配線VBP[n]に接続し、ビット線プリチャージ電圧VBPにチャージしようとする。

【0021】図26は、従来の構成によるビット線プリチャージ電源配線VBP[n]の、プリチャージ回路4102の活性時における動作を示す。前述のようにビット線プリチャージ信号NEQがローレベルにされ、プリチャージ回路4102が活性化されると、活性化されていたビット線BL[n]、/BL[n]が、ビット線プリチャージ電源配線VBP[n]に接続されるが、その際に電流が消費され、電圧降下が発生する。ビット線プリチャージ電源配線VBP[n]と、ビット線プリチャージ電源配線VBP[0]は、インピーダンスを下げるようにメッシュ状に接続されているが、電圧の伝達は数ns程度の遅れを生じる。

【0022】ビット線プリチャージ電源配線VBP[0]は、プリチャージ電圧発生回路4200に接続されており、ビット線プリチャージ電源配線VBP[0]がビット線プリチャージ基準電圧VBPREFより低い電圧になった時点で、オペアンプ4301の出力であるドライバインバーブ信号PENがローレベル方向に下がり、Pチャネルトランジスタ4302がオンになり、ビット線プリチャージ電源配線VBP[0]にハイレベル電圧が供給される。ハイレベル電圧が供給され、ビット線プリチャージ電源配線VBP[0]が、ビット線プリチャージ基準電圧VBPREFより高い電圧になった時点で、オペアンプ4301の出力であるドライバイン

8

バーブ信号PENがハイレベル方向に上がり、Pチャネルトランジスタ4302がオフになる。

【0023】Pチャネルトランジスタ4302が電流能力を必要とし、比較的大きなサイズ($W=50\mu m$ 以上)が用いられるため、ドライバインバーブ信号PENは、ビット線プリチャージ電源配線VBP[0]と、ビット線プリチャージ基準電圧VBPREFの関係に対して遅れを生じ、図に示すようにPチャネルトランジスタ4302の流す電流 i_a も遅れを生ずる。

【0024】

【発明が解決しようとする課題】次の読み出し動作の際に安定して読み出すためには、ビット線BL[n]、/BL[n]の電圧を所定の範囲内に収める必要があるが、従来のビット線プリチャージ電圧発生装置4200では、オペアンプ4301の動作が遅く、プリチャージ動作を高速化することが困難であり、問題である。オペアンプ4301の消費電流を増加させることで、プリチャージ動作を高速化することは可能となるが、消費電力の増加が問題となる。

【0025】本発明は、ビット線のプリチャージ動作を高速・高精度に行なうことを可能とした半導体記憶装置を提供することを目的とする。

【0026】

【課題を解決するための手段】本発明の半導体記憶装置は、複数のメモリセルと、前記メモリセルが接続されたビット線対と、第1の制御信号に応じて前記ビット線対を第1の電圧にプリチャージするための複数のプリチャージ回路と、前記プリチャージ回路にプリチャージ用の電圧を供給するビット線プリチャージ電圧発生装置とを備え、ビット線のイコライズ電圧と前記第1の電圧が異なる。前記ビット線プリチャージ電圧発生装置は、前記第1の電圧を発生して前記プリチャージ回路に供給するプリチャージ電圧発生回路と、第1のキャパシタと、前記第1のキャパシタを充電する充電手段と、前記第1のキャパシタと前記プリチャージ回路との接続・切断を制御するトランスファークロップ回路と、前記充電手段と前記トランスファークロップ回路を制御する第1の制御回路とを具備する。前記第1の制御回路は、前記ビット線のプリチャージ時に前記第1のキャパシタと前記プリチャージ回路とを接続するように前記トランスファークロップ回路を制御する。

【0027】この構成によれば、プリチャージ動作時に第1のキャパシタの電荷を放出することにより、ビット線のプリチャージ動作を高速に行なうことができる。

【0028】上記構成において、前記プリチャージ電圧発生回路は、第2の電圧を発生する基準電圧発生装置と、前記第1の電圧を前記第2の電圧と等しい電圧に駆動するドライバ回路とを備え、前記ドライバ回路の出力と、前記プリチャージ回路とが接続されている構成とすることができる。

【0029】また、上記構成において好ましくは、前記第1のキャパシタはソース・ドレインが接地された第1のMOSトランジスタで構成され、前記充電手段は、ゲートが第2の制御信号に、ソースが第1の外部電源に、ドレインが前記第1のMOSトランジスタのゲートに接続された第1のPチャネルMOSトランジスタで構成され、前記トランスファークローク回路は、ゲートに第2の制御信号が入力され、ソースを前記第1のMOSトランジスタのゲートに、ドレインを前記第1のインバータの出力が入力され、ソースを前記第1のMOSトランジスタのゲートに、ドレインを前記プリチャージ回路に接続された第2のPチャネルMOSトランジスタで構成される。

【0030】それにより、最小の回路構成で高速にビット線のプリチャージ動作を高速に行うことができる。

【0031】また、前記第1の制御回路は、前記第1の制御信号が、前記プリチャージ回路を活性化させる電圧にされてから第1の遅延時間の後に前記第2の制御信号を第1の電圧レベルに制御し、さらに第2の遅延時間の後に、前記第2の制御信号を第1の電圧レベルと逆相の電圧に制御する構成とすることができる。

【0032】この構成によれば、ドライバー回路が活性化された後に、第1のキャパシタより電流が供給されるため、ビット線のプリチャージ動作を高速に行うことができる。

【0033】また、第1の外部電源電圧と前記第2の電圧との差を第1の電圧差とし、前記ビット線対の各電圧の平均の電圧と前記第2の電圧との差を第2の電圧差とし、同時にプリチャージする前記ビット線対の総静電容量を第1の静電容量とすると、前記第1のキャパシタの静電容量は、前記第1の電圧差に対する前記第2の電圧差の比に前記第1の静電容量を乗じた第2の静電容量に等しい構成とすることができる。

【0034】また好ましくは、第1の外部電源電圧と前記第2の電圧との差を第1の電圧差とし、前記ビット線対の各電圧の平均の電圧と前記第2の電圧との差を第2の電圧差とし、同時にプリチャージする前記ビット線対の総静電容量を第1の静電容量とすると、前記第1のキャパシタの静電容量は、前記第1の電圧差に対する前記第2の電圧差の比に前記第1の静電容量を乗じた第2の静電容量の約50%から80%の値である構成とする。

【0035】それにより、第1のキャパシタの放電による第1の電圧の上昇と、ドライバー回路からの上昇による電圧の上昇による電圧の過上を防ぎ、高精度にビット線のプリチャージ動作を高速に行うことができる。

【0036】また、上記構成において、前記複数のメモリスセルのデータで、リフレッシュ制御信号に応じてリフ

レッシュするための機能を有し、リフレッシュ動作時には、通常動作より多くの前記ビット線対を活性化するように構成され、前記第1の制御回路は前記リフレッシュ制御信号がリフレッシュ動作を示すレベルの時のみに、前記第1の制御信号に応じて前記トランスファークローク回路を開放する構成とすることができる。

【0037】この構成によれば、リフレッシュ動作時にビット線のプリチャージ動作を高速に行うことができる。また、第1のキャパシタの静電容量をリフレッシュ動作時のみに必要な大きさとすることが可能となり、回路面積を削減でき、回路構成を単純化することが可能となる。

【0038】また、上記構成において、テスト信号が入力されることによりテストモードに入る機能を有し、前記テストモードでない場合には、前記第1の制御信号に応じて前記トランスファークローク回路を開放し、前記テストモードの場合には、前記ドライバー回路が停止し、前記ドライバー回路の出力がハイインピーダンスとなり、前記トランスファークローク回路を閉じている構成とすることができる。

【0039】この構成によれば、例えば検査時など、外部よりビット線のプリチャージ動作を印加し、動作のマージン等の確認を行なう際に、容易に、所望の電圧を実現することが可能となる。

【0040】また、前記プリチャージ電圧発生回路は、前記複数のプリチャージ回路のうち、最遠部近傍に配置された前記プリチャージ回路に供給される前記第1の電圧を前記第2の電圧と比較し、その比較結果に基づいて、最近部近傍に配置された前記プリチャージ回路に供給される前記第1の電圧を駆動する構成とすることができる。

【0041】この構成によれば、供給されるメモリアレイ全体に対して、ビット線プリチャージ電圧発生装置より速いメモリアレイに対しても、比較的高速にビット線のプリチャージ動作を行なうことができる。

【0042】また、前記複数のメモリスセルは複数のメモリアレイブロックに区分され、各々の前記メモリアレイブロックは、前記第1の制御信号によって同時に駆動される前記複数のプリチャージ回路に接続された前記複数のメモリスセルを含み、前記メモリアレイブロックごとにノイズキャンセラーが配置され、前記ノイズキャンセラーは、第2のインバータと、第2のキャパシタで構成され、前記第1の制御信号が前記第2のインバータに入力され、前記第2のインバータの出力が、前記第2のキャパシタの1端子に入力され、前記第2のキャパシタの別端子に、前記プリチャージ用の電圧が供給される構成とすることができる。

【0043】この構成によれば、第1の制御信号による、ビット線のプリチャージ電圧へのカップリングノイズの影響を相殺することが可能となり、高精度・高速に

ビット線のプリチャージ動作を行なうことができる。

【0044】また、本発明の他の構成の半導体記憶装置は、複数のメモリセルと、前記メモリセルが接続されたビット線対と、第1の制御信号に応じた複数のプリチャージ回路と、前記プリチャージ回路にプリチャージ用の電圧を供給するビット線プリチャージ電圧発生装置とを備え、ビット線のイコライズ電圧と前記第1の電圧が異なり、さらに第3の制御信号に応じて同時に活性化させる前記ビット線対の数を変更する機能を有する。前記ビット線プリチャージ電圧発生装置は、前記第1の電圧を発生して前記プリチャージ回路に供給するプリチャージ電圧発生回路と、複数のキャパシタ制御回路と、前記複数のキャパシタ制御回路を制御する第2の制御回路とを具備する。各々の前記キャパシタ制御回路は、第3のキャパシタと、前記第3のキャパシタを充電する充電手段と、前記第3のキャパシタと前記プリチャージ回路との接続・切断を制御するトランスファゲート回路から構成される。前記第2の制御回路は、前記第3の制御信号に応じて、制御する前記複数のキャパシタ制御回路の数を

変更する機能を具備する。

【0045】この構成によれば、第2の制御信号により、活性化ブロックを変更可能な半導体記憶装置において、活性化ブロックの大きさに基づく高速にビット線のプリチャージ動作を行なうことが可能となり、最適なビット線プリチャージ電圧発生装置を提供することが可能となる。

【0046】

【発明の実施の形態】（第1の実施形態）図1は、本発明の第1の実施形態におけるビット線プリチャージ電圧発生装置が搭載された半導体記憶装置の回路ブロック図を示す。メモリアレイ4000、電源ブロック4002、プリチャージ電圧発生回路4200、およびビット線プリチャージ電源配線VBP[n]は、従来例の構成と同じである。半導体記憶装置の機能ブロック構成は、図19に示した従来の構成と同様である。また、メモリアレイ4000を構成するメモリアレイブロック4001（図19参照）の回路構成も、図20に示した従来の構成と同様である。

【0047】100はビット線プリチャージ電圧発生装置である。ビット線プリチャージ電圧発生装置100内には、従来と同じ構成のプリチャージ電圧発生回路4200に加えて、チャージタンク回路101、および充放電制御回路102が含まれる。ビット線プリチャージ電圧発生装置100は、ビット線プリチャージ電源配線VBP[n]のうち、もともと近接するビット線プリチャージ電源配線VBP[0]に接続される。

【0048】図2は、プリチャージ電圧発生回路4200、およびチャージタンク回路101の回路図を示す。チャージタンク回路101は、第1のキャパシタ20

0、第1のPチャネルトランジスタ201、第2のPチャネルトランジスタ202、第1のNチャネルトランジスタ203、第1のインバータ204、バッファインバータ205から構成される。CPNDは電荷蓄積ノード、AP、NAP、ACPはトランスファゲート接続信号を示す。プリチャージ電圧発生回路4200の回路構成は、従来例の構成と同じである。

【0049】第1のキャパシタ200の1端子は、第1のPチャネルトランジスタ201、第2のPチャネルトランジスタ202、第1のNチャネルトランジスタ203のドレインに接続され、他方の端子は接地される。第1のキャパシタ200の静電容量Cca pは、同時にプリチャージされるビット線BL[n]、/BL[n]の総容量をCblとしたときに、ビット線BL[n]、/BL[n]の電位をビット線プリチャージ基準電圧VBPREFまでチャージするのに必要な電荷と等しくなる（VBPREF=1/2VDD）×Cblを蓄積できるような大きさが必要となる。動作時にはオープン4301により供給される電荷分を考慮し、静電容量Ccap<（VBPREF-1/2VDD）/（VDD-VBPREF）×Cblが用いられる。

【0050】第1のPチャネルトランジスタ201のゲートにはトランスファゲート接続信号APが入力され、ソースは外部電源VDDに接続される。第2のPチャネルトランジスタ202のゲートにはトランスファゲート接続信号NAPが入力され、ソースはビット線プリチャージ電源配線VBP[0]に接続される。第1のNチャネルトランジスタ203のゲートにはトランスファゲート接続信号APが入力され、ソースはビット線プリチャージ電源配線VBP[0]に接続される。第1のインバータ204の入力にはトランスファゲート接続信号APが供給され、出力はトランスファゲート接続信号NAPを構成する。バッファインバータ205は、偶数段のインバータの直列接続で構成され、入力にはトランスファゲート接続信号ACPが供給され、出力はトランスファゲート接続信号APを構成する。

【0051】図3は、充放電制御回路102の回路図を示す。300は第1の遅延素子、301は第2の遅延素子、302は第2のインバータ、303は第1のNOR素子である。第1の遅延素子300の遅延時間は τ_1 であり、入力にはビット線プリチャージ信号NEQ、出力は第2の遅延素子301、第1のNOR素子303に入力される。第2の遅延素子301の遅延時間は τ_2 であり、出力は第2のインバータ302の入力に接続される。第2のインバータ302の出力は第1のNOR素子303に入力され、第1のNOR素子303の出力はトランスファゲート接続信号ACPとなる。

【0052】図4は、ビット線プリチャージ電圧発生装置100のプリチャージ動作時における動作タイミング図、および主要ノードの電圧を示す。この図を参照しな

がら動作の説明を行なう。本発明によるビット線プリチャージ電圧発生装置が搭載される半導体記憶装置の動作タイミングは、図25に示されるものと同じである。

【0053】ビット線プリチャージ信号NEQがローレベルにされ、プリチャージ回路4102（図20参照）が活性化されると、センスアンプ4101により電位をVDD、VSSにされていたビット線BL[n]、/BL[n]の電位がイコライズされ、1/2VDDの電位にチャージされようとする。プリチャージ回路4102は同時に、ビット線BL[n]、/BL[n]に対応するビット線プリチャージ電源配線VBP[n]に接続し、ビット線プリチャージ電圧VBPにチャージしようとする。その際に電流が消費され、電圧降下が発生する。

【0054】ビット線プリチャージ電源配線VBP[n]に電圧降下が発生すると、メッシュ状に接続される配線を通して、ビット線プリチャージ電源配線VBP[0]にも電圧降下が伝達される。それを検知してオープン4301が活性化するが、Pチャネルトランジスタ4302の流す電流i_aが大きくなるまでには時間を要する。

【0055】ビット線プリチャージ信号NEQがハイレベルの場合には、トランスファゲート接続信号APはローレベルで、第2のPチャネルトランジスタ202、第1のNチャネルトランジスタ203はオフであり、また第1のPチャネルトランジスタ201はオンであり、電荷蓄積ノードCPNDはハイレベルにチャージされており、第1のキャパシタ200には電荷が蓄積されている。

【0056】ビット線プリチャージ信号NEQがローレベルにされると、第1の遅延素子300で決まる遅延時間τ₁の後にトランスファゲート接続信号APはハイレベルとなり、第1のPチャネルトランジスタ201はオフとなり、第2のPチャネルトランジスタ202、第1のNチャネルトランジスタ203がオンする。これにより、第1のキャパシタ200と、ビット線プリチャージ電源配線VBP[0]が電気的に接続されて、電流i_bが流れる。電荷蓄積ノードCPNDにはハイレベルが接続されており、電流i_bにより、ビット線プリチャージ電源配線VBP[0]は急速に電圧レベルが上昇する。

【0057】レベルの上昇を受けてオープン4301はPチャネルトランジスタ4302をオフする方向に動作を変えるが、流す電流i_aが小さくなるまでには時間を要する。

【0058】その後、第2の遅延素子301で決まる遅延時間τ₂の後にトランスファゲート接続信号APがローレベルとなり、第2のPチャネルトランジスタ202、第1のNチャネルトランジスタ203がオフし、また第1のPチャネルトランジスタ201がオンし、電荷蓄積ノードCPNDはハイレベルにチャージされ、次の

プリチャージ動作に備えられる。

【0059】以上のように、本実施形態によれば、ビット線BL[n]、/BL[n]をハイレベルにプリチャージする際に、動作の遅れを生じるオープン4301に、第1のキャパシタ200に蓄積された電荷を放電する機能を追加することで、急速に、プリチャージ動作を終了することが可能となり、半導体記憶装置の動作を高速に行なうことが可能となる。

【0060】（第2の実施形態）図5は、本発明の第2の実施形態におけるビット線プリチャージ電圧発生装置が搭載された半導体記憶装置500の機能ブロック図を示す。従来の半導体記憶装置に関して説明した要素と同様の要素については、同一の参照番号を付けて説明を省略する。501は制御回路、502はロウコントローラ、503は電源ブロックである。REFENは、リフレッシュ動作イネーブル信号である。以下の記載においては、従来と異なる部分を中心として説明する。

【0061】制御回路501には、外部クロック信号CLK、ロウアドレスストロブ信号NRAS、カラムアドレスストロブ信号NCAS、ライト制御信号NW、アドレスAADDR、リフレッシュ制御信号REFが入力される。制御回路501から出力されるリフレッシュ動作イネーブル信号REFENが、ロウコントローラ502、電源ブロック503に入力される。

【0062】図6は、本実施形態によるビット線プリチャージ電圧発生装置が搭載された半導体記憶装置のノーマル動作及びリフレッシュ動作時において、それぞれ活性化されるメモリアレイブロック4001の状態を示す。リフレッシュ動作イネーブル信号REFENがローレベルの場合にはノーマル動作となり、図6(a)に示すように、ロウコントローラ502からは、1つのメモリアレイブロック4001に対してビット線プリチャージ信号NEQ、センスアンプ起動信号SAN、SAP、ワード線駆動信号WL[63:0]が出力される。リフレッシュ動作イネーブル信号REFENがハイレベルの場合にはリフレッシュ動作となり、図6(b)に示すように、ロウコントローラ502からは、複数のメモリアレイブロック4001に対してビット線プリチャージ信号NEQ、センスアンプ起動信号SAN、SAP、ワード

線駆動信号WL[63:0]が出力される。

【0063】図7に、本実施形態における半導体記憶装置の回路ブロック図を示す。メモリアレイ4000、電源ブロック4002、プリチャージ電圧発生回路4200、ビット線プリチャージ電源配線VBP[n]は、従来例の構成と同じである。また、メモリアレイブロック4001の回路構成も、図20に示した従来の構成と同様である。第1の実施形態における要素と同一の参照符号が付された要素は、同一の構成を有する。700は充放電制御回路である。

【0064】本実施形態の構成が第1の実施形態と異な

15

る点は、充放電制御回路700の構成、およびチャージタンク回路101内に配置される第1のキャパシタ200(図2参照)の静電容量Ccapが、リフレッシュ時に活性化されるビット線対の総容量に応じて最適化されているという点である。

【0065】図8に、本実施形態における充放電制御回路700の回路図を示す。102は、第1の実施形態における充放電制御回路と同一の回路構成ブロックを示し、800は第1のAND素子である。第1の実施形態における充放電制御回路102の出力は、第1のAND素子800に入力される。第1のAND素子800の他の入力にはリフレッシュ動作イネーブル信号REFENが入力され、出力はトランスファゲート接続信号ACPとなる。

【0066】図9に、本実施形態における半導体記憶装置の、ノーマル動作及びリフレッシュ動作時のタイミング図を示す。

【0067】ノーマル動作時は第1の実施形態と同一であるが、リフレッシュ制御信号REFはハイレベルとされる。リフレッシュ制御信号REFがハイレベルとされるとリフレッシュ動作イネーブル信号REFENがローレベルとされる。リフレッシュ動作イネーブル信号REFENがローレベルであると、充放電制御回路700の出力、すなわち第1のAND素子800の出力であるトランスファゲート接続信号ACPはローレベルとなる。従って、トランスファゲート接続信号APはローレベル固定となり、第1のキャパシタ200に蓄積される電荷の放電が行なわれない。

【0068】リフレッシュ制御信号REFが外部クロック信号CLKの立ち上がりエッジでローレベルにされると、リフレッシュ動作イネーブル信号REFENがハイレベルとされ、内部リフレッシュカウンタ等で決まるワードアドレスに対応する複数のメモリアレブブロック4001に接続されるビット線ブリチャージ信号NEQがハイレベルにされる。所定の期間後、ビット線ブリチャージ信号NEQがローレベルにされると、トランスファゲート接続信号APがハイレベルとなる。それにより、第1のキャパシタ200に蓄積される電荷の放電が行われ、高速にビット線ブリチャージ動作が行なわれる。更に第2の遅延素子301で決まる遅延時間 τ_2 の後に、トランスファゲート接続信号APがローレベルとなり、第1のキャパシタ200に電荷が蓄積される。

【0069】以上のように、本実施形態によれば、リフレッシュ動作時に第1のキャパシタ200に蓄積された電荷を放電する機能を追加することにより、ノーマル動作より多くのビット線BL[n]、/BL[n]をハイレベルにブリチャージする際に、急速にブリチャージ動作を終了することが可能となり、半導体記憶装置のブリチャージ動作を高速に行なうことが可能となる。

【0070】(第3の実施形態)図10は、本発明の第

16

3の実施形態における半導体記憶装置1000の回路ブロック図を示す。従来例あるいは第1の実施形態と同一の参照符号が付された要素は、同一の構成を有する。PTESTはビット線ブリチャージ電源テスト信号、1001は制御回路、1002は電源ブロック、1003はビット線ブリチャージ電圧発生装置、1004は充放電制御回路、1005は外部パッドである。

【0071】電源ブロック1002内には、ビット線ブリチャージ電圧発生装置1003が配置され、ビット線ブリチャージ電圧発生装置1003は、充放電制御回路1004、チャージタンク回路101、ブリチャージ電圧発生回路4200で構成される。制御回路1001には、ビット線ブリチャージ電源テスト信号PTESTが入力され、さらにビット線ブリチャージ電源テスト信号PTESTは充放電制御回路1004に入力される。外部パッド1005が、ビット線ブリチャージ電圧VBPに接続されている。

【0072】図11は充放電制御回路1004の回路図を示す。102は実施形態1と同じ充放電制御回路、100は第3のインバータ、1101は第2のAND素子である。充放電制御回路102の出力が第2のAND素子1101に入力され、ビット線ブリチャージ電源テスト信号PTESTが、第3のインバータ1100に入力される。第3のインバータ1100の出力は、差動アンプ制御信号AMPENとして供給されるとともに、第2のAND素子1101に入力される。第2のAND素子1101の出力は、トランスファゲート接続信号ACPとなる。

【0073】以上のように構成された半導体記憶装置1000の動作を説明する。ビット線ブリチャージ電源テスト信号PTESTがローレベルの場合にはノーマル動作であり、第1の実施形態と同様の動作を行なうことが可能となる。またビット線ブリチャージ電源テスト信号PTESTがハイレベルの場合には、差動アンプ制御信号AMPENはローレベルとなり、オープン4301は停止し、トランスファゲート接続信号ACPはローレベル固定となり、ビット線ブリチャージ電圧VBPへの電流供給は行なわれない。

【0074】以上のように本実施形態に拠れば、ビット線ブリチャージ電源テスト信号PTESTをハイレベルにすることで、ビット線ブリチャージ電圧VBPへの電流供給が行なわれなくなり、外部パッド1005から例えばブローピング検査などで任意の電圧を印加することが可能となり、例えば、動作マージン評価等を行なうことが可能となる。

【0075】(第4の実施形態)図12は、本発明の第4の実施形態における半導体記憶装置の回路ブロック図を示す。従来例あるいは上記の実施形態と同一の参照符号が付された要素は、同一の構成を有する。1200はビット線ブリチャージ電圧発生装置、1201はブリチ

ヤージ電圧発生回路である。ビット線ブリチャージ電圧発生装置 1200 は、ブリチャージ電圧発生回路 1201、チャージタンク回路 101、充放電制御回路 102 で構成される。ビット線ブリチャージ電圧発生装置 1200 には、ビット線ブリチャージ電源配線 VBP [n] が接続される。

【0076】図 13 は、本実施形態によるブリチャージ電圧発生回路 1201、チャージタンク回路 101 の回路図を示す。チャージタンク回路 101 の回路構成は第 1 の実施形態と同一である。ブリチャージ電圧発生回路 1201 は、従来例におけるブリチャージ電圧発生回路 4200 に対して、オペアンプ 4301 の + 入力にビット線ブリチャージ電源配線 VBP [0] が接続されている代わりに、ビット線ブリチャージ電源配線 VBP [n] が接続されている点が異なる。

【0077】以上のような構成とすることで、ビット線ブリチャージ電源配線 VBP [0] からビット線ブリチャージ電源配線 VBP [n] の間のインピーダンスが存在するが、ビット線ブリチャージ電源配線 VBP [n] に接続されるメモリアレイブロック 4001 が活性化した場合でも、高速にブリチャージ動作を行なうことが可能となる。またビット線ブリチャージ電源配線 VBP [0] に接続されるメモリアレイブロック 4001 が活性化した場合には、オペアンプ 4301 の検知までに時間を要するが、電圧降下が電源回路近傍に発生することから、ブリチャージ動作に問題となるような遅れを生じない。従ってメモリアレイ 4000 全体で高速にブリチャージ動作を行なうことができる。

【0078】(第 5 の実施形態) 図 14 は、本発明の第 5 の実施形態における半導体記憶装置 1400 の回路ブロック図を示す。従来例あるいは上記の実施形態と同一の参照符号が付された要素は、同一の構成を有する。1401 はノイズキャンセル回路である。

【0079】ノイズキャンセル回路 1401 は、メモリアレイ 4000 内に配置され、メモリアレイブロック 4001 内を通過するビット線ブリチャージ信号 NEQ に結合される。

【0080】図 15 は、ノイズキャンセル回路 1401、およびメモリアレイブロック 4001 の回路図を示す。1500 は第 4 のインバータ、1501 は第 2 のキャパシタである。メモリアレイブロック 4001 の回路構成は従来例と同一である。

【0081】第 4 のインバータ 1500 の入力にはビット線ブリチャージ信号 NEQ が入力され、出力は第 2 のキャパシタ 1501 に接続される。第 2 のキャパシタ 1501 の他方の端子は、ビット線ブリチャージ電源配線 VBP [n] に接続される。第 2 のキャパシタ 1501 の静電容量は、ビット線ブリチャージ信号 NEQ と、ビット線ブリチャージ電源配線 VBP [n] との間にトランジスタを介して存在する寄生容量と同一の静電容量

とされる。

【0082】ビット線ブリチャージ信号 NEQ をハイレベルもしくはローレベルに駆動する際に、トランジスタを介して存在する寄生容量を介してビット線ブリチャージ電源 VBP [n] にノイズが発生するが、本構成によれば、そのノイズを第 2 のキャパシタ 1501 のキャパシタ容量によりキャンセルすることができ、従ってビット線のブリチャージをより精度よく行なうことができる。

【0083】(第 6 の実施形態) 図 16 は、本発明の第 6 の実施形態における半導体記憶装置 1600 の回路ブロック図を示す。従来例あるいは上記の実施形態と同一の参照符号が付された要素は、同一の構成を有する。1601 は制御回路、1602 は電源ブロック、1603 はビット線ブリチャージ電圧発生装置、101B は第 2 のチャージタンク回路、1604 はロウコントローラ、1605 はカラムコントローラである。

【0084】制御回路 1601 には、外部クロック信号 CLK、ロウアドレスストロブ信号 NRS、カラムアドレスストロブ信号 NCAS、ライト制御信号 NWE、アドレス ADDR、リフレッシュ制御信号 REF、およびページ長制御信号 PGMD が入力される。制御回路 1601 より出力される内部ページモード制御信号 1PG は、カラムコントローラ 1605、ロウコントローラ 1604、ビット線ブリチャージ電圧発生装置 1603 に入力される。

【0085】図 17 は、本実施形態における半導体記憶装置の活性化ブロックの選択の説明図である。図 17

(a) に示すように、内部ページモード制御信号 1PG がローレベルの場合は、ロウコントローラ 1604 より、1つのメモリアレイブロック 4001 に対してビット線ブリチャージ信号 NEQ、センスアンプ駆動信号 SAN、SAP、ワード線駆動信号 WL [63:0] が出力される。図 17 (b) に示すように、内部ページモード制御信号 1PG がハイレベルの場合には、2つのメモリアレイブロック 4001 に対して、それぞれのビット線ブリチャージ信号 NEQ、センスアンプ駆動信号 SAN、SAP、ワード線駆動信号 WL [63:0] が出力される。

【0086】図 18 は、本実施形態におけるビット線ブリチャージ電圧発生装置 1603 のブロック図を示す。1800 は第 3 の AND 素子である。ブリチャージ電圧発生回路 4200 の出力、チャージタンク回路 101 の出力、および第 2 のチャージタンク回路 101B の出力は、ビット線ブリチャージ電源配線 VBP [0] に接続される。第 2 のチャージタンク回路 101B の回路構成は、図 2 に示したチャージタンク回路 101 と同一である。チャージタンク回路 101 および第 2 のチャージタンク回路 101B 内に配置される第 1 のキャパシタ 2000 の静電容量は、それぞれが 1つのメモリアレイブ

ック4001内に配置されるビット線BL[n]、ノブL[n]を充電するのに必要な静電容量とされる。

【0087】チャージタンク回路101内のパッファインバータ205には、充放電制御回路102から出力されるトランスファゲート接続信号ACPが入力される。

第2のチャージタンク回路101B内のパッファインバータ205には、第3のAND素子1800の出力が入力される。第3のAND素子1800には、内部ページモード制御信号IPG、および充放電制御回路102から出力されるトランスファゲート接続信号ACPが入力される。

【0088】上記構成の動作を説明する。内部ページモード制御信号IPGがローレベルの場合には、ビット線プリチャージ信号NEQがローレベルにされ、プリチャージ動作が開始されると、活性化されている1つのメモリアレイブロック4001内に配置されたビット線BL[n]、ノブL[n]がプリチャージされる。その際、チャージタンク回路101のみが動作し、第2のチャージタンク回路101Bは停止している。内部ページモード制御信号IPGがハイレベルの場合には、ビット線プリチャージ信号NEQがローレベルにされ、プリチャージ動作が開始されると、活性化されている2つのメモリアレイブロック4001内に配置されるビット線BL[n]、ノブL[n]がプリチャージされる。その際には、チャージタンク回路101が動作するとともに、第3のAND素子1800の出力がハイレベルとなり第2のチャージタンク回路101Bが動作する。

【0089】本構成によれば、同時に活性化されるメモリアレイブロック4001の数が異なる場合にも、それぞれ高速にプリチャージ動作を行なうことが可能となり、動作を高速化できる。

【0090】

【発明の効果】本発明によれば、従来のオペアンプのみによるビット線プリチャージ電圧発生装置に、キャパシタから放電を行なうチャージタンク回路を設けることにより、ビット線のプリチャージ動作を高速・高精度に行なうことが可能となり、半導体記憶装置の回路動作を高速化することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施形態における半導体記憶装置の回路ブロック図

【図2】 第1の実施形態におけるプリチャージ電圧発生回路およびチャージタンク回路の回路図

【図3】 第1の実施形態における充放電制御回路の回路図

【図4】 第1の実施形態におけるプリチャージ動作時の動作タイミング、および主要ノードの電圧を示す図

【図5】 第2の実施形態における半導体記憶装置の機能ブロック図

【図6】 第2の実施形態における半導体記憶装置のノ

ーナル動作及びリフレッシュ動作時に活性化されるメモリアレイブロックの構成図

【図7】 第2の実施形態における半導体記憶装置の回路ブロック図

【図8】 第2の実施形態における充放電制御回路の回路図

【図9】 第2の実施形態における半導体記憶装置のノーマル動作及びリフレッシュ動作時のタイミング図

【図10】 第3の実施形態における半導体記憶装置の回路ブロック図

【図11】 第3の実施形態における充放電制御回路の回路図

【図12】 第4の実施形態における半導体記憶装置の回路ブロック図

【図13】 第4の実施形態におけるプリチャージ電圧発生回路およびチャージタンク回路の回路図

【図14】 第5の実施形態における半導体記憶装置の回路ブロック図

【図15】 第5の実施形態におけるノイズキャンセル回路およびメモリアレイブロックの回路図

【図16】 第6の実施形態における半導体記憶装置の回路ブロック図

【図17】 第6の実施形態における半導体記憶装置の活性化ブロック選択の説明図

【図18】 第6の実施形態におけるビット線プリチャージ電圧発生装置のブロック図

【図19】 従来の一般的なDRAMの機能ブロック図

【図20】 従来のメモリアレイブロックの回路図

【図21】 従来のビット線プリチャージ電圧の電源配線ネットを示す図

【図22】 従来のプリチャージ電圧発生回路の回路図

【図23】 従来の基準電圧発生回路の回路図

【図24】 従来のオペアンプの回路図

【図25】 従来のDRAMの動作タイミングおよび内部電圧タイミングのタイミング図

【図26】 従来のビット線プリチャージ電源配線の電圧と、プリチャージ回路の活性時の電流を示す図

【符号の説明】

100 ビット線プリチャージ電圧発生装置

101 チャージタンク回路

101B 第2のチャージタンク回路

102 充放電制御回路

200 第1のキャパシタ

201 第1のPチャネルトランジスタ

202 第2のPチャネルトランジスタ

203 第1のNチャネルトランジスタ

204 第1のインバータ

205 パッファインバータ

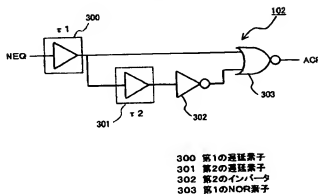
300 第1の遅延素子

301 第2の遅延素子

21

302 第2のインバータ
 303 第1のNOR素子
 500 半導体記憶装置
 501 制御回路
 502 ロウコントローラ
 503 電源ブロック
 700 充放電制御回路
 800 第1のAND素子
 1000 半導体記憶装置
 1001 制御回路
 1002 電源ブロック
 1003 ビット線プリチャージ電圧発生装置
 1004 充放電制御回路
 1005 外部パッド
 1100 第3のインバータ
 1101 第2のAND素子
 1200 ビット線プリチャージ電圧発生装置
 1201 プリチャージ電圧発生回路
 1400 半導体記憶装置
 1401 ノイズキャンセル回路
 1500 第4のインバータ
 1501 第2のキャパシタ
 1600 半導体記憶装置
 1601 制御回路
 1602 電源ブロック
 1603 ビット線プリチャージ電圧発生装置
 1604 ロウコントローラ
 1605 カラムコントローラ
 1800 第3のAND素子
 4000 メモリアレイ
 4001 メモリアレイブロック
 4002 電源ブロック
 4003 ロウコントローラ
 4004 カラムデコーダー
 4005 制御回路
 4006 I/Oバッファ

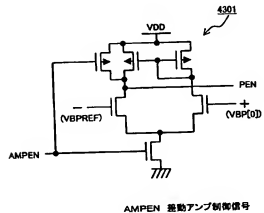
【図3】



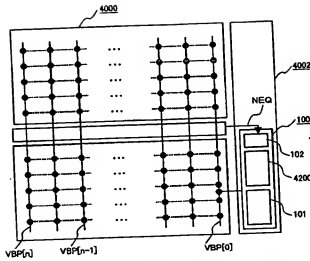
22

4100 メモリセル
 4101 センスアンプ
 4102 プリチャージ回路
 4103 アクセストランジスタ
 4104 キャパシタ
 4200 プリチャージ電圧発生回路
 4300 基準電圧発生回路
 4301 オペアンプ
 4302 Pチャネルトランジスタ
 10 4400、4401 抵抗
 5000 DRAM
 AMPEN 差動アンプ制御信号
 AP、NAP、ACP トランスファゲート接続信号
 BL[n]、/BL[n] ビット線
 CAD カラムアドレス信号
 CLK 外部クロック信号
 CPND 電荷蓄積ノード
 DI データ入力信号
 DO データ出力信号
 20 IPG 内部ページモード制御信号
 NCAS カラムアドレスストロブ信号
 NRAS ロウアドレスストロブ信号
 NWE ライト制御信号
 PEN ドライバインネプル信号
 PGMD ページ長制御信号
 PTEST ビット線プリチャージ電源テスト信号
 RAD ロウアドレス信号
 REF リフレッシュ制御信号
 REFEN リフレッシュ動作インネプル信号
 30 SE アクセスコントロール信号
 VBP ビット線プリチャージ電圧
 VBP[n] ビット線プリチャージ電源配線
 VBPREF ビット線プリチャージ基準電圧
 VCP メモリセルプレート電圧
 VOUT ビット線プリチャージ保持電圧
 WEN ライトインネプル信号

【図24】

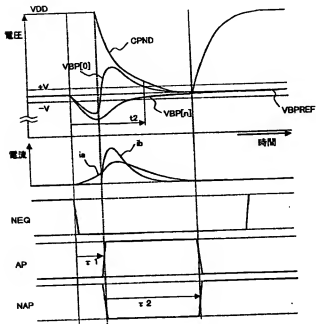


【図1】

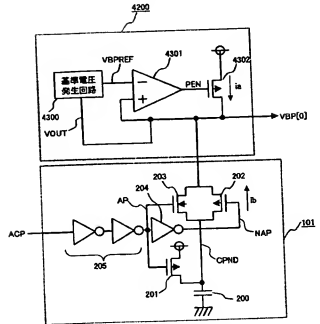


100 ビット線プリチャージ電圧発生装置
 101 チャージタンク回路
 102 充放電制御回路
 4200 プリチャージ電圧発生回路
 VBP[n] ビット線プリチャージ電源配線

【図4】

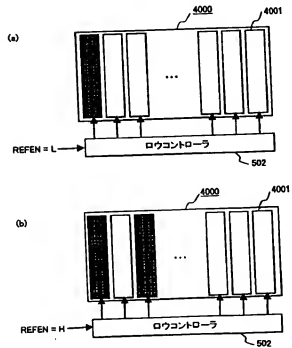


【図2】

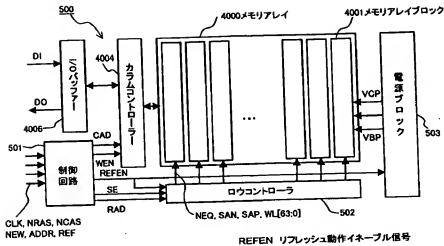


200 第1のキャパシタ
 201 第1のPチャネルトランジスタ
 202 第2のPチャネルトランジスタ
 203 第1のNチャネルトランジスタ
 204 第1のインバータ
 205 トリプルインバータ
 CPND 電荷蓄積ノード
 AP, NAP, ACP トランスファゲート接続信号

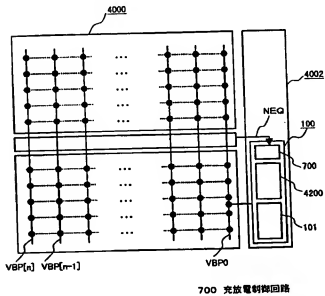
【図6】



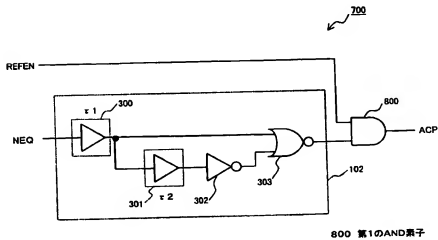
【图5】



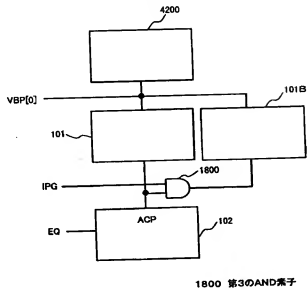
【图7】



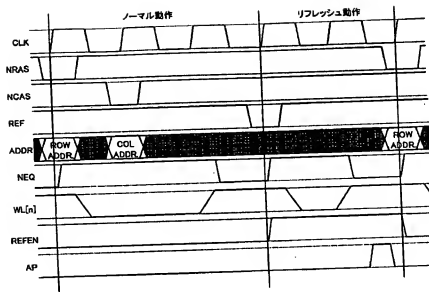
【图 8】



【图 18】



【図 9】



【図 10】

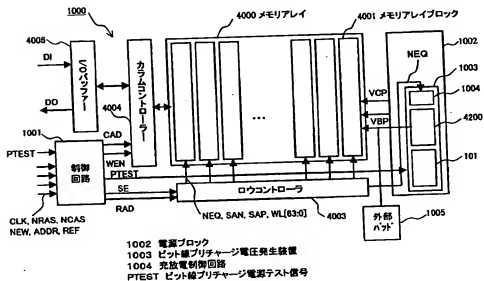
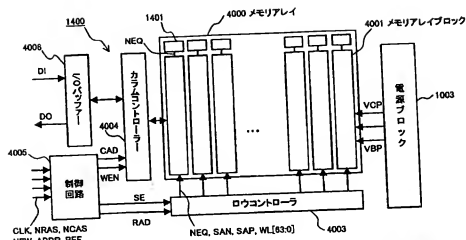


Figure 1 is a logic circuit diagram of a first embodiment. The circuit includes a PTEST input, an AMPEN output, an ACP output, and a NEQ input. A signal path starts from NEQ, passes through an inverter (300), then through a series of inverters (301, 302), and finally through an AND gate (303). The output of the AND gate (303) is connected to the ACP output. The AMPEN output is connected to the output of the AND gate (303) and also to the output of an inverter (1100). The output of the inverter (1100) is connected to the PTEST input. A reference numeral 1004 points to the AMPEN output line.

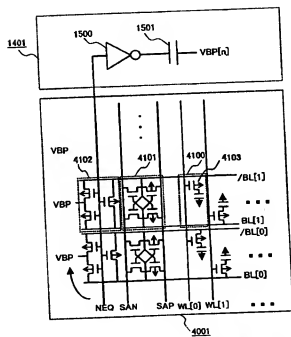
Figure 1 is a schematic diagram of a memory array structure. It shows a grid of memory cells (represented by dots) connected to word lines (horizontal lines) and bit lines (vertical lines). The word lines are labeled VBP[n], VBP[n-1], and VBP[0]. The bit lines are labeled 100, 102, 101, and 103. The array is divided into two main sections by a vertical line, with the left section labeled 4000 and the right section labeled 4002. The right section contains a vertical stack of components labeled 102, 100, 101, and 103.

【例 14】



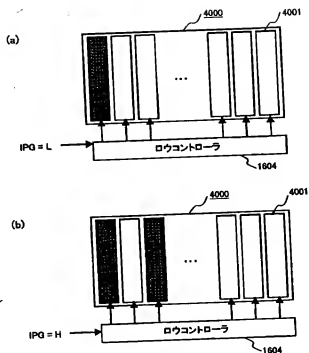
1401 ノイズキャンセル回路

【図15】

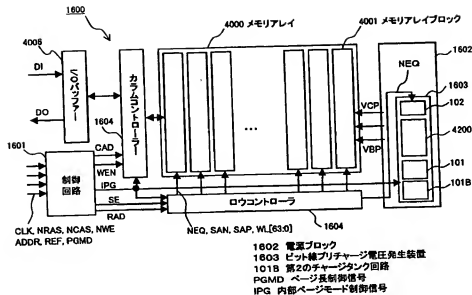


1500 第4のインバータ
1501 第2のキャパシタ

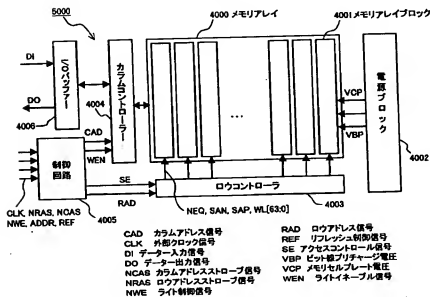
【圖 17】



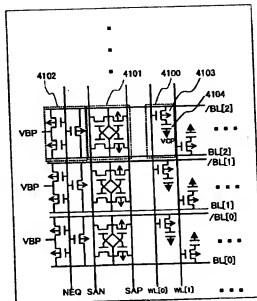
【図16】



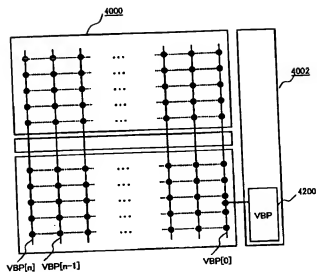
【図19】



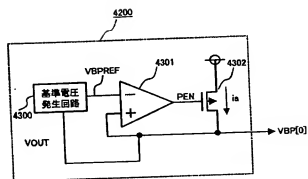
【図20】



【図21】

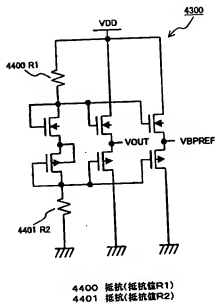


【図22】

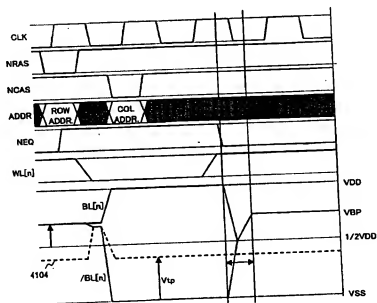


4301 オペアンプ
 4302 Pチャネルトランジスタ
 VBPREF ビット線プリチャージ基準電圧
 VOUT ビット線プリチャージ保持電圧
 PEN ドライバーイネーブル信号

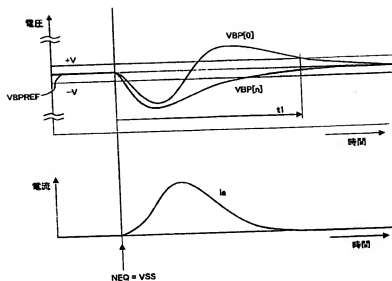
【図23】



【図25】



【図26】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷G11C 11/409
29/00

識別記号

671

FI

G11C 11/34

G01R 31/28

フーリエ (参考)

371A

B

W

(72) 発明者 廣瀬 雅庸

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

Fターム (参考) 26132 AA08 AK15 AK16 AL00

5L106 AA01 DD11 EE02

5M024 AA23 AA50 BB15 BB29 BB35

BB39 BB40 CC63 CC65 EE30

FF08 FF20 FF23 HH11 LL01

MM04 MM10 PP01 PP02 PP03

PP07